

## ЛАЗЕРНЫЕ ДИОДЫ

**VCSEL** лазерный диод – это диод, который излучает оптический луч в вертикальном направлении по отношению к подложке. Он предназначен для использования в качестве источника света в оптических системах и оптических устройствах захвата.

Лазерный диод с вертикальным объемным резонатором (**VCSEL**) содержит оптический резонатор, который состоит из активной области и верхнего и нижнего отражателя. Нижний отражатель, в свою очередь, состоит из брэгговского отражателя и неоптического подавляющего слоя, расположенного между активным слоем в активной области и нижним рефлектором.

Наименование	Длина волны, нм	Мощность, мВт	При токе, мА	Расхождение пучка, градус	Ток управления, мА	Диапазон рабочих температур, °С	Тип корпуса
<b>HFE4084-322</b>	850	1.25	12	15	5 - 15	0...70	ТО-46
<b>HFE4070-500</b>							

ТО-46



SMD

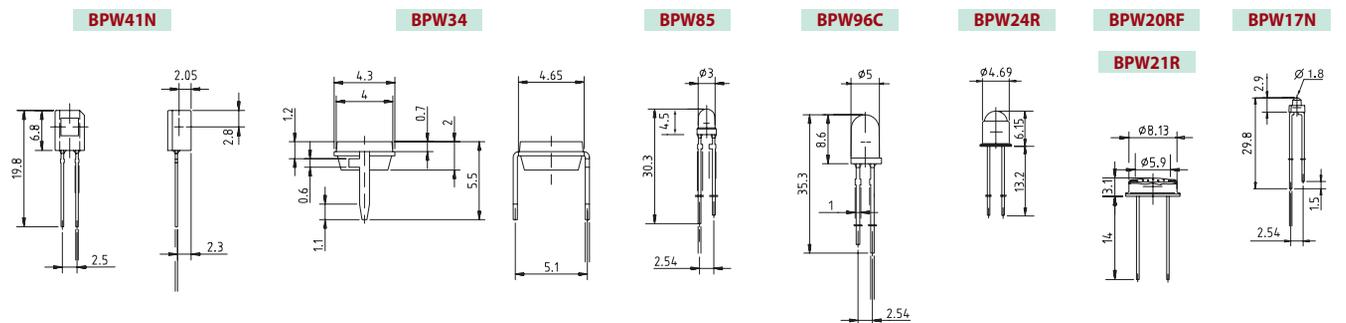


## ФОТОДИОДЫ И ФОТОТРАНЗИСТОРЫ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Тип	Угол 2Θ1/2 °	Длина волны, нм	Диапазон волн, нм	Максимальный темновой ток коллектора, нА	Материал	Макс. раб. частота, кГц	Диапазон рабочих температур, °С	Площадь чувствительного элемента, мм²
<b>BPW17N</b>	фототранзистор	24	825	620 - 960	200	кремний	120	-55...+100	0.36
<b>BPW20RF</b>	фотодиод	100	920	550 - 1040	34	кремний	70	-55...+125	7.5
<b>BPW21R</b>	фотодиод	100	565	420 - 675	30	кремний	80	-55...+125	7.5
<b>BPW24R</b>	PIN фотодиод	24	900	600 - 1050	10	кремний	35700	-55...+125	0.78
<b>BPW34</b>	PIN фотодиод	130	900	600 - 1050	30	кремний	2500	-55...+100	7.5
<b>BPW41N</b>	PIN фотодиод	130	950	870 - 1050	30	кремний	2500	-55...+100	7.5
<b>BPW85B</b>	фототранзистор	50	850	620 - 980	200	кремний	180	-55...+100	0.18
<b>BPW85C</b>	фототранзистор	50	850	620 - 980	200	кремний	180	-55...+100	0.18
<b>BPW96C</b>	фототранзистор	40	850	620 - 980	200	кремний	180	-55...+100	0.18

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



## ФОТОТРАНЗИСТОРЫ

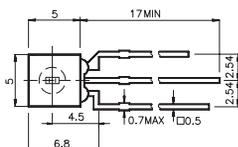
### СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

<b>КР</b>	<b>3216P3</b>	<b>С</b>
1	2	3

1. Тип
2. Размер, мм
3. Тип линзы: ВТ - голубая прозрачная, С - бесцветная.

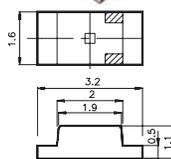
### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение пробоя:  
 Коллектор-эмиттер ..... 30 В  
 Эмиттер-коллектор ..... 5 В  
 Макс. темн. коллект. ток ..... 100 нА  
 Раб. коллект. ток: ..... 0.3 мА



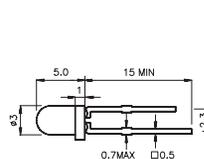
**L-610MP4BT/BD**

п-р-п транзистор  
5 x 5 x 3 мм



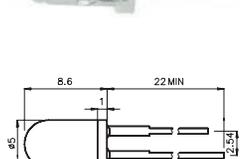
**KP-3216P3C**

3.2 x 1.6 x 1.1 мм  
(1206)



**L-3DP3C (L-32P3C)**

Ø = 3 мм  
Итемн. = 100 нА



**L-53P3C**

Ø = 5 мм  
Итемн. = 100 нА